(19)대한민국특허청(KR)공개특허공보(A)

(51) Int.Cl. 6 C25D 5/56

출원번호	10-1999-7008155
출원일자	1999년09월08일
공개번호	특2000-0076067
공개일자	2000년12월26일
번역문 제출일자	1999년09월08일
우선권주장	191601
국제출원번호	PCT/JP1999/02180
국제출원일자	1999년04월23일
국제공개번호	20
국제공개일자	2000년01월13일
대리인	강동수
	강일우
	최정연
	홍기천
발명자	모리히데유키
	구마가이마사시
출원인	가부시키가이샤 쟈판 에나지노미야마 아키히콰
심사청구	있음
발명의명칭	금속도금 전처리제 및 그것을 사용하는 금속도금 방법



본 발명은, 분말체나 경면물에 대해서도 용이하게 적용할 수 있는 무전해도금 방법을 제공하고, 또한, 그 방법을 위한 금속도금 전치리제를 제공한다. 이 전치리제는, 귀금속이온과 복합체를 형성하는 활성관능기를 가진 아즐게 화합물과 애폭시실란계 화합물과의 반응에 의해 얻어진 실란커플경제를 포함하여 구성한다. 이것을 사용하여 표면처리한 피도 금물을 귀금속이온을 합유하는 용액으로 처리한 후, 무전해도금함으로써 금속도금을 행한다.



* 배경기술

무전해금속도금법은 전도율이 없는 기판에 금속피막을 형성하는 방법의 하나이며, 무전해도금의 전처리로서 팔라듐 등의 귀금속을 촉매로서 미리 기판에 부착시켜 놓은 활성화라고 하는 방법을 사용하는 것이 일반적이다. 지금까지, SnCl2의 염산성수용액으로 처리한 후 PdC12수용액에 참지처리함으로써 Pd를 기판 위에 흠착시키거나. Sn과 Pd를 할유한 콜로이드용액에 의해 Pd를 표면에 담지시키는 방법이 사용되어 왔다. 이들 방법은 Sn을 사용하는 관점에서 복 잡한 처리공정 등 문제가 많다. 그래서 최근, 무전해도금의 촉매로 사용되는 Pd 등의 귀금속을 표면에 당지시키는 방 법으로서 이들 귀금속류와 복합체를 형성할 수 있는 관능기를 가진 실라커플링제를 사용한 방법이 여러 가지로 제안 되어 있다(일본 특공소 59-52701, 일본 특개소 60-181294, 일본 특개소 61-194183 및 일본 특개평 3-44149), 그 러나, 이 중에 나타나 있는 실란커플링제를 기판에 균일하게 흡착시키고자 하면 종래의 아미노실란커플링제나 에폭시 실란커플링제는, 수용액 속에서 탈수소축합반응에 의해 결화하기 쉬워 고농도로 용해할 수 없을 것이다. 또한, 유기 용제 속에서는 가수분해축합이 거의 일어나기 어렵고, 대부분이 모노머로 존재하기 때문에 액의 점성이 낮다. 이 때문 에, 그러한 실란커플링제가 경면물상에 균일하게 도포하여도 막의 두께의 조정이 어렵기 때문에, 커플링제는 단지 얇 은 막을 제공할 수 있었다. 이 때문에, 귀금속을 포획하는 관능기가 표면에 소량밖에 존재할 수 없기 때문에, 후속공정 에서의 도금 촉매의 기능을 가진 귀금속이 불균일하게 부착될 수 있다. 이 결과로서 무전해도금막을 균일하게 형성하 는 것이 어려웠다. 이 때문에 경면유리표면에의 무전해도금은, 표면을 불화수소산이나 뜨겁게 한 강알카리액에 의해 표면을 거칠게 하는 방법이 현재도 행하여지고 있다. 또한, 분말체에의 처리에서도, 종래의 아미노실란커플링제 및 에 폭시실란커플링제는 표면에의 부착이 적기 때문에, 처리액의 용매를 완전히 휘발시켜 커플링제를 강제적으로 분말표 면에 부착시킨 후, 가열건조하여 가수분해축합시키지 않으면 안되었다.

[발명의 개시]

본 발명은 이러한 관점에서 중래 방식으로 무전해도금을 거의 적용하기 어려웠던 분말체나 경면물에 대해서도 성공적 으로 무전해도금이 가능한 신규의 무전해도금에 의한 금속도금 방법 및 그를 위한 금속도금 전처리제를 제공하는 것 을 목적으로 하는 것이다.

본 발명자는, 예의 검토한 결과, 상술한 문제들이 상기 귀금속이온과 복합체 형성기능을 가진 실란커플링제로서 특정 한 실란커플링제를 선택함으로써 해결할 수 있는 것을 발견하여, 본 발명에 이르렀다.

즉. 본 발명은.

- (1) 귀금속이온과 복합체를 형성하는 활성관능기를 가진 아졸계 화합물과 에폭시실란게 화합물과의 반응에 의해 얻어 진 실란커플링제를 포함하여 구성하는 금속도금 전처리제.
- (2) 귀금속이온과 복합체를 형성하는 활성관능기를 가진 아줄계 화합물과 에폭시실란계 화합물과의 반응에 의해 얻어 진 실란커플링제로 표면처리한 피도금물을 귀금속이온을 함유하는 용액으로 처리한 후, 무전해도금하는 것을 특징으로 하는 금속도금 방법.
- (3) 상기 (2)에 있어서, 아졸계 화합물이 이미다졸류인 것을 특징으로 하는 금속도금 방법,
- (4) 상기 (2)에 있어서, 귀금속이온이 팔라듐이온인 것을 특징으로 하는 금속도금 방법,
- (5) 상기 (2)에 있어서, 무전해도금이 동 또는 니켈인 것을 특징으로 하는 금속도금 방법에 관한 것이다.

[발명을 실시하기 위한 최량의 형태]

본 발명은, 무전해도금의 촉매인 PC 등의 귀금속을 피도금면에 담지시키기 위해서 사용하는 실란커플링제, 또는 귀금 속과 목함체 형성할 수 있는 상기 관능기를 가진 실란커플링제로서, 귀금속이온과 목함체를 형성할 수 있는 활성관능 기를 가진 아졸계화한문과 애폭시실관계 화한문과의 분응생성을 사용하는 것이 중요하다.

상기 아출계 화합물로서는, 피롤, 인돌, 이미다졸, 피리종, 벤즈이미다졸, 인다졸 등을 등 수 있는데, 이들에 제한되는 것이 아니다. 또한 상기 에폭시실란계 화합물로서는, 문자 내에 에폭시기와 알콕시실틸기를 가진 화합물이며, 일반적 으로 Ŷ -글리시독시프로필알콕시실란을 포함하지만, 이에 제한되는 것이 아니다. 아졸계 화물과 에폭시실란의 화물과의 반응으로 얻어진 실러커플링제 자체는 이미 공지이다. 예를 들면 일본 특계됐습-7563586 공보에 이미다족 화합물과 에폭시실란과의 반응에 의해 이미다출실란화합물을 얻는 것이 계시되어 있다; 그러나 다른 아졸계 화합물과 의 반응도 이와 마찬가지로 하여 행할 수 있다. 이 반응생성물인 실란거플링제는, 분자사이 및 분자 내축 함물을 포함 한 상태로 얻어지는 경우가 있는데, 특히 이들을 분리할 필요는 없고 혼합물은 사용할 수 있다. 당한 있는데, 들이 이들을 분리할 필요는 없고 혼합물은 조점하여 임의 농도를 가진 수용액으로 조정을 할 수 있다. 또한, 용해한 용액에 이는 정도의 점상을 제공한다. 그래서, 피막이 이 실만쇠플링제를 사용함으로써 피도금물의 기초표면에 어느 정도의 점상을 제공한다. 그래서, 피막이 이 의마실란 등의 커플링제로는 거의 도금되기 어려웠던 경면물상이나 용매를 증발하지 않으면 처리할 수 없었던 분망체 등도 포함하여 각종 기초표면에 대하여 용이하게 무전해도금이 가능하다. 상기 귀급속으로서는, 무전해도금액으로부터 교도금물 표면에 동이나 니켈 등의 금속을 석출시킬 때의 촉매효과를 나타내는 팔라돔, 은, 백급, 금 등을 들 수 있는데, 특히 팔라돔이 바람직하다.

본 발명의 금속도금 방법에 의하면, 피도금물은 그들의 성상에 제한되지 않는다. 유리 및 세라믹 등의 무기재료: 폴리 에스테르, 롬리아미드, 폴리이미드 및 북소수지 등의 플라스틱째로: 평돔, 시트, 성유 및 필요에 파다 유리포기출자 등으로 강화된 애폭시수지 등의 절연판 등의 절연물: Si 웨이퍼를 포함하는 반도체 등의 낮은 전도율을 가진 피도금물에 적용할 수 있지만, 피도금물은 투명유리판, Si웨이퍼 및 기타 반도체기판 같은 경면물 및 문압체를 포함하여 본 발명 의 방법을 성격적으로 실시할 수 있다. 이러한 분말제로서는, 유리비드, 이황화물리브덴분당, 산화마그네슘분당, 흑 연분망, SiC분압, 산화지르코늄분망, 알루미나분말, 산화규소분말, 마이카후레이크, 유리섬유, 질화규소, 테프론분말, 등을 들 수 있다.

무전해도금하는 기초표면을 상기한 비와 같은 아들계 화합물과 에폭시실란계 화합물과의 반응생성물인 실란커플링제 로 처리하는 경우, 이 실란커플링제는 용액을 만들기 위하여, 물, 메틸알콜, 에틸알콜, 2-프로판용, 아세톤, 톨루엔, 에틸렌글리콜, 폴리에틸렌글리콜어나 이들을 혼합한 용매 등의 적절한 용매에 용해될 수 있다. 판형상의 기초표면에 대해서는, 참지처리나 브러시 도포로 기초표면교링한 후에 용매를 증발시키는 방법이 일반적이지만, 이에 한정되는 짓은 아니다. 표면에 균일하게 실란커플링제를 부착시키는 방법이 먼다. 또한, 분말체에 대하는, 참지처리 후 용매를 증발시켜 강제적으로 용액 속에 포함되는 실란커플링제를 보자 문 표면에 부착시키는 방법 외에 이 실란커플링제가 교원한 성막상에 의해 참지상태로 기초표면에 흡착이 가능하기 때문에, 처리 후 용매를 여과하여 습한 분말체를 건조시키는 방법도 가능하다

처리하는 용액증의 실단커플링제 농도는 이에 한정된 것은 아니지만, 일반적으로 0.001~10중량%이 실용적이다. 0.001중량% 미만의 경우, 기초재의 표면에 부착하는 커플링제량이 낮아지기 쉬워, 효과를 얻기 어렵다. 또한, 10 중량%을 남으면 부착량이 지나치게 많아 건조되기 어렵거나, 문발의 응집이 일어나기 쉬워진다. 표만처리 후에 사용한 용매를 중발시키는 데에는, 이 용매의 휘발온도이상으로 가열하여 표면을 건조할 수 있으면 충분하지만, 더욱 60~1207은 10~60분가 가영거조하는 것이 바라직하다.

상기와 같이 하여 표면처리한 것에 대하여 화확도금하는 방법은 공지의 방법이다. 즉, 팔리듐 등의 귀금속이온을 포함 한 용액과 접혹시키, 기초표면에 처리된 커플링웨의 아폴기에 귀금속을 포착시킨다. 여분의 칼로겐화물 등의 가용성 귀금속염 및 염산 등의 가용화제를 세정 후, 무전해도금 등의 화학도금처리를 행한다.

또한, 무전해도금을 최초로 행하여 금속 박막을 형성시켜, 전도율이 없는 기초표면에 어느 정도의 전도율을 갖게 한후, 전기도금이나 비금속(卑金屬)과의 치환도금을 했하는 것도 가능하다.

본 발명에 의해 무전해도금에 의해 동, 니켈, 코발트, 주석 또는 금 등의 금속을 도금할 수 있는데, 본 발명에 사용하는 무전해도금액의 대표적인 것을 기록하면 이하의 것이 있다.

① 고속 및 두꺼운 도금용 무전해 동도금 조성물의 대표예

CuSO4.5H2O 0.04~0.06몰/1

EDTA.2Na 0.04~0.12몰/1

HCHO(37%) 0.08~0.5몰/1

pH 12~12.5

도금 온도 70~90℃ ② 저온무전해동도금 조성물의 대표예 CuSO4.5H2O 12.5~14.5g/1

HCHO(37%) 20~25 g/1

로첼염 25~40 g/1

pH 12.2~12.5

도금 온도 20∼30℃

③ 고온산성욕으로서 무전해 Ni 도금 조성물의 대표예

황산니켈 20~22 g/1

유산 25~30 g/1

프로피온산 2~3 g/1

차아인산나트륨 20~22g/1

pH 4.5~5.5

도금 온도 80~90℃

④ 저온 암모니아알카리성욕으로서 무전해 Ni도금 조성물의 대표예

황산니켈 24~26 g/1

피로인산나트륨 48~52 g/l

차아인산나트륨 24~26 g/l

pH 10~11

도금 온도 55~65℃

*기술적 과제

본 발명은, 낮은 전도율을 가진 재료, 경면물이나 분말체 등의 표면상에 무전해도금에 의해 금속도금하는 방법 및 그를 위한 금속도금 전처리제에 관한 것이다.

ል 설업상 이용 기통성

이상 설명한 바와 같이 본 발명의 신규의 금속도금 전처리제를 사용하는 무전해도금법에 의하면, 중래 방법에서는 쉽 게 적용하기 어려운 경면물이나 분말체에 대해서도 바람직하게 무전해도금을 행할 수 있고, 피도금물의 성상, 형상에 제하되는 일이 없다.

실시예 1

두께 1mm의 슬라이드유리판을 알카리탈지액으로 처리한 후, 이 유리판 표면상에 이미다출과 가 '-글리시독시포로필 트리메톡시실한과의 등목 반응생성물인 실각하플릭제를 0. 4중량% 합유한 2-프로판용 완액을 사용하여 500 RPM으로 스피닝코팅하였다. 그 후, 이 판을 105 C에서 30분간 건조하였다. 또한 P전황성화역 CG-535A(활성제, 닛코 메탈 플레이팅(주)제)에 실온으로 1분간 참지한 후, 탈이온수 약 10mm로 수세하여 105 C에서 30분간 건조하여 유리판 표 데에 귀금속으로 활성화처리를 행하였다. 다음에 활성화된 유리판을 무전해내활도금액 나의 가(시 그 메탈플레이팅 (주)제)중에 80℃로 4분간 참지하였다. 무전해내활도금액에 의해 유리 전체면에 균일하게 광택이 있는 막이 석출하고 있으며, 셀로판 테이프에 의한 박리도 없이 양호한 밀착성을 가지는 것이 확인되었다.

비교예 1

두께 1mm의 슬라이드유리판을 알카리탈지액으로 처리한 후, 표면에 커플링제처리하지 않고 Pd활성화액 CG-535A 로 실온으로 1분간 침지한 후, 탈이온수 약 100ml로 수세하고 105℃에서 30분간 건조하여 유리판표면에 귀금속으 로 활성화처리를 행하였다. 다음에 활성화된 유리판을 무전해니켈도금액 니코무 7N 중에 80℃로 4분간 침지하였다. 무전해니켈도금막은 유리판에 거의 석출하지 않았다.

비교예 2

두께 1mm의 슬라이드유리판을 불화수소산 및 집산혼합액(불화수소산 100ml/L, 집산100ml/L)에 25°0에서 10분간 최지함으로써 표면에 거친 화학적 처리를 하였다. 이 유리판을 알카리탈지액으로 처리하고, Pd활성화액 CG-535A에 실온으로 1분간 참지한 후, 탈이온수 약 100ml로 수세하고 105°0에서 30분간 건조하여 유리판표면에 귀금속으로 활 성화처리를 행하였다. 다음에 활성화된 유리판을 무전해니켈도금액 니코무 7N 중에 80°0로 4분간 참지하였다. 무전해니켈도금약은 유리판에 되어 살충하지 않았다.

비교예 3

두께 1mm의 슬라이드유리판을 알카리탈지액으로 처리한 후, 이 유리판표면상에 아미노실란커플링제 KBM-903(신

에초화학공업(주)제 [™] -아미노프로필트리메톡시실란)을 0.4중량% 함유한 2-프로판용용액을 사용하여 500 RPM으로 스피니코링하였다. 그 후 ,이 판을 105 50세 30분간 건조하였다. 또한 Pc화성화액 CG-6354에 실온으로 1분간 참지한 후, 탈이온수 약 100ml으로 수세하고 105℃에서 30분 건조하여 유리판표면에 귀금속으로 황성화차리를 행하 였다. 다음에 무건하네겔도금액 니코무 7N 속에 80℃로 4분간 참지하였다. 무전해니켈도금은 유리판의 일부밖에 석 송하지 않았다.

비교예 4 및 5

가수분해축합반응을 촉진시키기 위해서 물과 2-프로판을 등량의 혼합액에 미량의 염산을 가한 후 용액에 아미노실란 커플링제 KBM-903을 0.4중령% 또는 그 농도를 10배로 한 4중량%(비교에 5)를 용해한 액을 제조하였다. 비교에 3과 마찬가지로 하여 귀금속활성화처리를 행한 후, 무전해니켈도금을 각 활성화된 판에 행하였다. 무전해도금은 양쪽 모 두 실절적으로 유리판의 반정도로 드로드문하게 밖에 석출하지 않았다.

실시예 2

페트 필름(상품명: 다이어포일)을 2-프로판올속에서 5분간 초음파세정하여 표면을 탈지처리한 후, 105℃에서 10분간 건조하였다. 다음에 이 필름을 이미다졸과 Ÿ-글리시독시프로필트리에톡시실란과의 등몰 반응생성물인 실란커플링 제를 4중량% 함유한 2-프로판을 용액중에 1분간 참지한 후 105℃에서 10분간 건조하였다. 또한 그 판을 Pd활성화액 CG-535A에 실온으로 1분간 참지한 후, 탈이온수로 수세하고 105℃에서 10분간 건조하여 페트필름 표면에 귀금속으로 활성화처리를 행하였다. 다음에 무전해동도금액 KC-500 (낫코 메탈플레이팅(주게)중에 72℃로 20분간 참지하였다. 무전해동도금이 페트 필름 전체면에 균일하게 광택이 있는 막을 석출하였다.

실시예 3

이미다음과 Y -글리시독시프로필트리메독시실란과의 등물 반응생성물인 실란커를링제를 0.4 증량 참 함타 2.-프로 만음생성점에 유리포기초교육 가전 애국시구집설만파(마산시타 랜교(주)제 동교단계층판 Fr.4 교육에서 동을 화학 예칭에 의해 제거한 판)을 1분간 참지한 후 105 ℃에서 60분간 건조하였다. 다음에 이 적충판을 Pd활성화액 CG-535A에 실 온으로 1분간 참지한 후, 탈이온수로 수세하고 105 ℃에서 60분간 건조하여 적충판 표면에 귀금속으로 활성화치리를 향하였다. 이 적충판 표면에 귀금속으로 함상하치리 양하였다. 이 적충판을 무전해동도금액 KC-500에 70℃로 30분간 참지한 후에, 무전해1젤로급막이 적충판에 균일하게 석출되었다. 또한, 유사하게 귀금속으로 활성화차리한 적충판을 무전해동도금액 KC-500에 70℃로 30분간 참지한 등이 표면에 균일하게 석출하였다.

비교예 6

실시에 3과 유사한 유리포기초재를 가진 에폭시수지접연판을 몰과 2-프로판을 등략의 혼합액에 미량의 엽산을 가한 다음 아미노실란커플링제 KBM-903을 0.4중량% 용해함으로써 제조된 용액에 1분간 참지한 후 105℃로 60분간 건조 하였다. 또한 기판을 P0활성화액 CG-535A에 실운으로 1분간 참지한 후, 빨0운수로 수세하고 105℃에서 60분간 건 조하여 적충판 표면에 귀금속으로 활성화치리를 행하였다. 이 판을 무전해니캠모금액 니코무 7N 중에 80℃로 2분간 참지한 후, 무전해니켐 도위안이 단지 전체 표면의 약 80% 정도 적충파상에 귀일하게 색출하면다.

실시예 4

약 1.5mm 직경의 유리비드 20g를 이미다졸과 ゲ -글리시독시프로필메틸디에톡시실란과의 등몰 반응생성물인 용해 된 실린커플링데 0.80g을 함유한 50ml의 2-프로판을 용액에 1분간 참지하였다. 엑을 여과한 후 105'6에서 30분간 건조하였다. 이 유리비드를 연찰성화액 (G급-535A에 실온으로 1분간 참지한 후, 이 활성화액을 여과하고 더욱 50ml 의 탈이온수로 수세하고 105'0에서 30분간 건조를 행하여 유리비드 표면에 귀금속으로 활성화처리하였다. 이 유리비 드를 무진해니챌도금역 너코무 7N 중에 80'0로 4분간 참지한 후 무전해니챌도금이 비드 전체면에 균일하게 석출하였다.

비교예 7

약 1.5mm 직경의 유리비드를 아미노실란커플링제 KBM-903를 0.4중량% 합유한 50ml의 2-프로판율용액에 1분간 참지하였다. 엑을 여과한 후 비드를 105°C에서 30분간 건조하였다. 이 유리비드를 Pd활성화액 CG-5355.50ml에 실 온으로 1분간 참지한 후, 이 활성화액을 여과하고 더욱 50ml의 탈이온수로 수세하고 105°C에서 30분간 건조를 행하 여 유리비드 표면에 귀금속으로 활성화저리하였다. 이 유리비드를 무전해나웹도금액 너고무 7% 중에 80°C로 4분간 참지한 후 무전해나웹도금막은 약 30% 이상의 비도금된 비드표면을 남기고 비드표면에 석출하였다.

실시예 5

비교예 8

평균입자직경 50마이크론의 이황화몰리브덴분말을 Pd활성화액 CG-535A 50ml에 실온으로 20분간 교반한 후, 이 활성화액을 여파재가하고 더욱 50ml의 탈이온수로 수세한 후 105℃에서 60분간 건조를 행하여 분말체 표면에 귀금속으로 활성화치리하였다. 이 이황화몰리브덴분말을 무전해동도금액 KC-500을 사용하여 72℃에서 도금을 행하였지만, 이 무전해동도금에 의해 동도금막은 거의 형성할 수 없었다.

실시예 6

평균입자직경 100마이크론의 산화마그네슘분발 50g을 이미다출과 olimits ' - 글리시독시프로필트리에독시실란과의 등물 반응생성물인 실란계를 대한 0.29을 용해 100메의 오-프로판용목에에 실온으로 10분간 교반하였다. 용매인 2-프로 판음을 증류제거한 후 105℃에서 30분간 건조하였다. 이 산화마그네슘분말을 Pd활성화맥 CG-535A 100메에 실은으로 20분간 교반한 후, 이 활성화맥을 여과제거하고 100메의 필이온수로 수세한 후 105℃에서 30분간 건조를 행하여 분당체 표면에 귀급속으로 활성화지리하였다. 이 산화마그네슘분말을 무전해동도금액 KC-505 사용하여 72℃에서 도금을 행하였다. 단지 1중량%의 무전해동도금에 의해 분망체 표면에 균일한 동도금막을 형성할 수 있고, 기초표면인 산화마그네슘을 원리히 덮을 수 있고, 기초표면인 산화마그네슘을 변하던 덮을 무성하는 있다.

실시예 7

평균입자직경 100마이]크론의 천연흑연분말 25g을 2~에탈~4~매틸이미다출과 7~글리시독시프로필트리메톡시실란과의 등물 반응생성물인 실란커클링제 0.1g을 용해한 50m의 에탄울용액에 실온으로 10분간 교반하였다. 용매인 2~로판율을 증류 제거한 후 흑연분말을 105 '0에서 30분간 건조한다. 이 흑연분말을 10분상화액 (G~535A 100m)에 실온으로 20분간 교반한 후, 이 활성화액을 여과제거하고 50m)의 탈이온수로 수세한 후 105 '0에서 30분간 건조를 하여 분말체 표면에 귀금속으로 활성화채리하였다. 이 흑연분말을 무전해동도금액 (C~500을 사용하여 72'C에서 도금 형 행하였다. 6 중량%의 무전해동도급에 에 의해 분말체 표면에 균일함 동도급막을 형성할 수 있었다. 또한, 유시하게 귀금속활성화한 흑연분말을 무전해니켈도금막이 실질적으로 표면에 균일하게 석출하여 분말체의 색이 흑색에서 희색으로 변하고, 기초표면을 니켈로 완전히 덮을 수 있었다.

실시예 8

평균입자직경 70마이크론의 SIC분말 8g을 이미다돌파 ↑ -글리시독시프로필트리메독시실라과 등물 반응생성률인 실란커플링제 0.2g을 용해한 100페의 메달용왕에의 실온으로 10분간 교반하였다. 용매인 메탑음을 증류 제거한 105℃에서 30분간 건조하였다. 이 SIC분말을 Pd활성화액 CG-535A I00페에 실온으로 20분간 교반한 후, 이 활성화 액을 여파하고 I00페의 탈이온수로 수세한 후 105℃에서 30분간 건조를 행하여 분말체 표면에 귀금속으로 활성화 권리하였다. 이 SIC분말을 무전해동도금액 KC-500을 사용하여 72℃에서 도금을 행하였다. 단지 1중말%의 무전해동 도금에 의해 분말체 표면에 균일한 동도급막을 형성할 수 있고, 분말은 완전한 동색으로 되고, 녹색의 SIC 분말을 완전히 당은 수 있었다.

비교예 9

평균입자직경 70마이크론의 SIC분말 50g을 Pd활성화액 CG-535A 100ml에 실온으로 20분간 교반하고, 이 활성화액을 여자하고 100 ml의 탈이온수로 수세한 후 105 ℃에서 30분간 건조를 행하여 분말체 표면에 귀금속으로 활성화처리하였다. 이 SIC분말을 무전해동도금액 KC-500을 사용하여 72℃에서 도금을 행하였다. 무전해동도금막을 분말체 표면에 형성할 수 있지만. SIC분말의 20% 이상을 닦을 수 없었다.

실시예 9

평균입자직경 30마이크론의 산화지르코늄분말 50g을 2-매틸이미다졸과 ^Y-글리시독시프로필트리에톡시실란과의 등물 반용생성물인 실란커플램제 0.2g을 용해한 100m1의 메탄울용맥에 실온으로 10분간 교반하였다. 용매인 메탄 울을 증류 제거한 후 105℃에서 30분간 건조하였다. 다음에 이 산화지르코늄분말을 Pd활성화맥 CG-535A 100ml에 서 실온으로 20분간 교반한 후, 이 활성화맥을 여과하고 100ml의 탈이온수로 수세한 후 105℃에서 30분간 건조를 행 하여 본말체 표면에 귀금속으로 활성화처리하였다. 이 산화지르코늄분말을 무전해니캩도금액 니코무 7N중에 80℃로 부분간 참지하면, 무전해니ౌ로금막이 산화지르코늄표면에 살잘적으로 균일하게 석출하여, 기초표면을 완전히 덮을 수 있었다.

실시예 10

직경 0.3mm의 테프론제 실 약 10을 이미다홍과 가 "글리시독시프로필트리메투시실라과의 등물 반응생성물인 실 런커플링제 0.02g을 용해한 250ml의 에단을용액에 실온으로 10분간 교반하였다. 용매인 에단을을 증류 제시하한 후 105℃에서 30분간 건조하였다. 이 실을 무연활성화액 (G-535A 50ml에 실온으로 20분간 참지한 후, 이 활성화액을 여 과하고 50ml의 탈이온수로 수세한 후 105℃에서 30분간 건조를 행하여 실의 표면에 귀금속으로 활성화처리하였다. 이 테프론제 실을 무전해니켈도금액 니코무 7N중에 80℃로 4분간 참지하면, 무전해니켈도금막이 실 표면에 균일하게 석출하여, 기초표면을 원전히 덮어 실이 회색이 되었다.



청구의 범위

청구항 1:

귀금속이온과 복합체를 형성하는 활성관능기를 가진 아졸계 화합물과 에폭시실란계 화합물과의 반응에 의해 얻어진 실란커플링제를 포함하여 구성하는 금속도금 전처리제.

청구항 2:

귀금속이온과 복합체를 형성하는 활성관능기를 가진 아졸계 화합물과 에폭시실란계 화합물과의 반응에 의해 얻어진 실란커플링제로 묘던처리한 피도금물을 귀금속이온을 함유하는 용맥으로 처리한 후, 무전해도금하는 것을 특징으로 하는 금속도구 방법

청구항 3:

제 2 항에 있어서. 아졸계 화합물이 이미다졸류인 것을 특징으로 하는 금속도금 방법.

청구항 4:

제 2 항에 있어서, 귀금속이온이 팔라듐이온인 것을 특징으로 하는 금속도금 방법.

청구항 5:

제 2 항에 있어서, 무전해도금이 동 또는 니켈인 것을 특징으로 하는 금속도금 방법,